17. WIN 1. ZVV7 7.4Z

TATEMIANH. LOUIS TOERLAU LORKENIZ

LOUIS · PÖHLAU · LOHRENTZ

PATENTAN EUROPEAN PATENT AND T

MARK ATTORNEYS

DIFL.-PHYS. CLAUS POHLAU DR.-ING. WALTER KÖHLER DR. ARMIN WALCHER (CHEM.) DIFLING. NORBERT ZUNSINGER DIFL.-PHYS. WOLFG. SEGETH DIFLING. E LOHRENTZ (1971-1999)

PER FAX VORAB

Europäisches Patentamt Erhardtstraße 27

80331 München

POSTANSCHRIFT/MAILING ADDRESS:
90014 NÜRNMERG/GEEMANY
POSTANSCHRIFT/MAILING ADDRESS:
90014 NÜRNMERG/GEEMANY
POSTANSCHRIFT/MAILING ADDRESS:
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20

HAUSANSCHRIFT/PREMISES: 90409 NÜRNBERG/GERMANY MERIANSTRASSE 26

JC06 Rec'd PCT/PTO

19 MAY 2005

M. 02.03/sh

T/46423WO/AW-8n

11. November 2004

Internat, Patentanmeldung

Offizieller Titel

: PCT/DE03/03770

: Organisches elektronisches Bauelement mit

strukturierter halbleitender Funktionsschicht und

Herstellungsverfahren dazu : Siemens Aktiengesellschaft

Anmelder / Inhaber

## Auf den Bescheld vom 11.08.2004:

Als Anlage wird ein neuer Anspruch 1 vorgelegt, der den ursprünglichen Anspruch 1 ersetzen soll. Die Ansprüche 2 bis 5 bleiben unverändert.

Der neue Anspruch 1 wurde dahingehend präzisiert, dass ein organisches elektronisches Bauelement mit einer strukturierten Funktionsschicht vorliegt, wobei

- die Funktionsschicht eine Dicke von kleiner 100 nm hat und
- die Strukturierung durch eine Präparation einer darunter liegenden Funktionsschicht des Bauelements erfolgt, und zwar in der Weise, dass die untere Funktionsschicht
  - a) Tellbereiche hat die benetzt werden und
  - b) Teilbereiche hat, die nicht benetzt werden.

BEST AVAILABLE COPY

Die neu aufgenommenen Merkmale sind in der ursprünglichen Beschreibung Seite 4 unten und Seite 5 oben offenbart.

Diese Kombination von Merkmalen ist aus keiner der Entgegenhaltungen bekannt.

D1 offenbart zwar eine strukturierte Funktionsschicht offenbart, jedoch findet keine Präparation einer unteren Funktionsschicht statt sondern die strukturierte Funktionsschicht wird in Tröpfchenform aufgebracht und die Strukturierung ergibt sich durch die Ausbreitungsflächen der Tropfen, wobei die Ausbreitungsflächen der Tropfen immer kleiner sind als der Abstand, in dem zwei benachbarte Tropfen aufgebracht werden.

Zudem ist aus der D1 keine Aussage über die Schlichtdicke der strukturierten Schicht bekannt.

D2 offenbart zwar zwei strukturierte Schichten mit Schlchtdicken kleiner 100 nm (zwischen 500 und 1000 Angström), aber keine organischen Funktionsschichten sondern Elektrodenschichten (vgl. dazu S. 13, Zeile 22 und 23 Source and drain layer 12 and 16 und Schichten aus sub-stolchiometric silicon oxide 19. (vgl. auch S.13 unten und Seite 14 oben). Die organische Funktionsschicht ist nicht strukturiert (siehe S. 13 oben).

Dr. Armin Walcher Patentanwalt Zusammenschluß Nr. 39 Anlagen Neuer Anspruch 1

BEST AVAILABLE COPY

**Neuer Anspruch 1:** 

1. Organisches elektronisches Bauelement mit einer strukturierten Funktionsschicht einer Dicke kleiner 100nm, wobei die Strukturierung der Funktionsschicht dadurch entsteht, dass eine untere Funktionsschicht durch eine Behandlung so präpariert ist, dass sie Tellbereiche hat, auf denen im nachfolgenden Prozessschritt Benetzung stattfindet und Tellbereiche, auf denen keine Benetzung erfolgt.